ГЕНЕРАЦИЯ ЭКСИТОНОВ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА МОЛЕКУЛАМИ В ОБОЛОЧКЕ СЛОИСТОЙ КОМПОЗИТНОЙ НАНОСТРУКТУРЫ С ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ

Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М. Центр лазерной и информационной биофизики, Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

При использовании слоистых композитных нанструктур в фотонике важным фактором управления их свойствами служит внешнее магнитное поле [1]. Наличие проводящих компонентов в структуре обусловливает магниточувствительность системы даже в отсутствие у нее ферро- или парамагнитных свойств. Это связано с зависимостью диэлектрической проницаемости электронной плазмы проводника от вектора индукции ${\bf B}$ внешнего магнитного поля [2]. В приближении холодной замагниченной плазмы тензор $\ddot{\varepsilon}^{(i)}(\omega | {\bf B})$ диэлектрической проницаемости в декартовой системе координат (${\bf B} = B_z {\bf n}_z$) записывается в виде

$$\vec{\varepsilon}^{(i)}(\boldsymbol{\omega} \mid \mathbf{B}) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & ig & 0 \\ -ig & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix}, \tag{1}$$

где компоненты тензора

$$\varepsilon_{\perp}(\omega \mid \mathbf{B}) = 1 - \frac{\omega_{p}^{2}(\omega + i\gamma)}{\omega[(\omega + i\gamma)^{2} - \Omega_{L}^{2}]}, \ \varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{\omega_{p}^{2}}{\omega(\omega + i\gamma)}, \ g(\omega \mid \mathbf{B}) = \frac{\omega_{p}^{2}\Omega_{L}}{\omega[(\omega + i\gamma)^{2} - \Omega_{L}^{2}]} \ (2)$$

а параметры

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_e}{m}}$$
 — ленгмюровская (плазменная) частота, $\Omega_L = \frac{e \, |\, {\bf B} \, |}{mc}$ — ларморовская (циклотронная) частота электрона в магнитном поле индукции **B**.

Тензоры, определяющие конфигурацию поля цилиндрического слоистого композита

Рассмотрим композитную слоистую систему с цилиндрической симметрией. Неполный анализ случая сферического композита проводился нами ранее в [3], но и он может быть полностью завершен по аналогии с решением задачи для цилиндрической системы, приведенным ниже.

Как и в случае слоистого шара, большой интерес для ряда приложений представляет тензор поляризуемости $\ddot{\mathbf{A}}(\omega|\mathbf{B})$ композита (в расчете на единицу его длины) в однородном поле \mathbf{E}_0 , посредством которого удобно производить

расчет характеристик ближнего поля снаружи цилиндра — у поверхности его внешнего слоя. Определим в цилиндрической системе координат (выбираем в качестве оси Z ось цилиндра) потенциалы $\Phi_j(r,\theta,z)$, j=1,2,3 поля во всех областях, отображенных на рис. 1. Выражения для этих потенциалов записываем по аналогии с ранее рассмотренным сферическим случаем и известной изотропной слоистой аксиальной системой, заменяя все скалярные коэффициенты изотропного случая их тензорными аналогами. Таким образом, подобно выражениям, приведенным в [3], можем записать

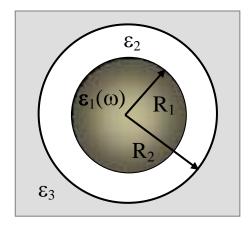


Рис. 1. Структура коаксиального слоистого нанокомпозита с проводящей жилой и диэлектрической оболочкой, помещенного в диэлектрическую среду с проницаемостью ε_3 .

$$\Phi_{1}(r,\theta,z) = -\mathbf{\ddot{B}}(\ddot{\varepsilon}_{1},\varepsilon_{2},\varepsilon_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r}, \tag{3}$$

$$\Phi_{2}(r,\theta,z) = -\mathbf{\ddot{C}}(\mathbf{\ddot{\varepsilon}}_{1},\varepsilon_{2},\varepsilon_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r} + \mathbf{\ddot{D}}(\mathbf{\ddot{\varepsilon}}_{1},\varepsilon_{2},\varepsilon_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r}/r^{2},$$
(4)

$$\Phi_{3}(r,\theta,z) = -\mathbf{\ddot{I}} \cdot \mathbf{E}_{0}\mathbf{r} + \mathbf{\ddot{A}}(\mathbf{\ddot{\varepsilon}}_{1}, \mathbf{\varepsilon}_{2}, \mathbf{\varepsilon}_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r} / r^{2}.$$
 (5)

Соотношения между неизвестными тензорами $\ddot{\mathbf{A}}, \ddot{\mathbf{B}}, \ddot{\mathbf{C}}, \ddot{\mathbf{D}}$ находим из условий на граничных поверхностях (окружностях) $C(R_1)$ и $C(R_2)$:

$$\Phi_1(R_1, \theta) = \Phi_2(R_1, \theta), \quad \Phi_2(R_2, \theta) = \Phi_3(R_2, \theta),$$
 (6)

$$\vec{\varepsilon}_{1}(\omega) \left(\frac{\partial \Phi_{1}}{\partial r} \right)_{R_{1}} = \varepsilon_{2} \left(\frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r} \right)_{R_{1}}, \quad \varepsilon_{2} \left(\frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r} \right)_{R_{2}} = \varepsilon_{3} \left(\frac{\partial \Phi_{3}}{\partial r} \right)_{R_{2}}. \tag{7}$$

Тогда на основе (3)-(5) и (6)-(7) можем получить

$$\ddot{\mathbf{B}} = \ddot{\mathbf{C}} - \ddot{\mathbf{D}} / R_1^2, \quad -\ddot{\mathbf{C}} + \ddot{\mathbf{D}} / R_2^2 = -\ddot{\mathbf{I}} + \ddot{\mathbf{A}} / R_2^2, \tag{8}$$

$$\vec{\varepsilon}_{1}(\omega)\vec{\mathbf{B}} = \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{C}} + \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{D}}/R_{1}^{2}, \quad \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{C}} + \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{D}}/R_{2}^{2} = \varepsilon_{3}\vec{\mathbf{I}} + \varepsilon_{3}\vec{\mathbf{A}}/R_{2}^{2}.$$
(9)

Последовательно исключая из (8) и (9) посредством линейных преобразований тензоры $\ddot{\mathbf{D}}, \ddot{\mathbf{C}}, \ddot{\mathbf{B}}$, получаем для тензора $\ddot{\mathbf{A}}$ дипольной поляризуемости единицы длины слоистого композитного цилиндра с анизотропной жилой следующее выражение

$$\ddot{\mathbf{A}} \left(\ddot{\varepsilon}_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3} \right) = \left[\left(\ddot{\varepsilon}_{1}(\omega | \mathbf{B}) + \varepsilon_{2} \right) \left(\varepsilon_{2} - \varepsilon_{3} \right) + \left(\ddot{\varepsilon}_{1}(\omega | \mathbf{B}) - \varepsilon_{2} \right) \left(\varepsilon_{2} + \varepsilon_{3} \right) \xi^{2} \right] \times \left[\left(\ddot{\varepsilon}_{1}(\omega | \mathbf{B}) + \varepsilon_{2} \right) \left(\varepsilon_{2} + \varepsilon_{3} \right) + \left(\ddot{\varepsilon}_{1}(\omega | \mathbf{B}) - \varepsilon_{2} \right) \left(\varepsilon_{2} - \varepsilon_{3} \right) \xi^{2} \right]^{-1} R_{2}^{2}, \tag{10}$$

где $\xi = R_1 / R_2$. Тензор $\ddot{\mathbf{B}}(\ddot{\varepsilon}_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, определяющий на основе (3) однородное поле в приосевой области может быть найден на основе следующего равенства

$$\begin{bmatrix} \vec{\varepsilon}_1(\omega) + \varepsilon_2 \vec{\mathbf{I}} \end{bmatrix} \vec{\mathbf{B}}(\omega) = -(\varepsilon_2 - \varepsilon_3) \vec{\mathbf{A}}(\omega) / R_2^2 + (\varepsilon_2 + \varepsilon_3) \vec{\mathbf{I}}.$$
(11)

Вектор \mathbf{E}_1 напряженности однородного поля в приосевой области (в корде) композита, вообще говоря, не коллинеарен вектору $\mathbf{E}_1 = \ddot{\mathbf{B}}(\vec{\varepsilon}_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\mathbf{E}_0$.

Если проводящей в композите является оболочка, а корд — диэлектрический, действуя аналогичным образом для тензора $\ddot{\mathbf{A}}\left(\varepsilon_1, \ddot{\varepsilon}_2(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_3\right)$ поляризуемости слоистого цилиндрического композита с замагниченной проводящей оболочкой получаем

$$\ddot{\mathbf{A}}(\varepsilon_{1}, \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{3}) = \\
= \left[\left(\varepsilon_{1} + \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \right) \left(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) - \varepsilon_{3} \right) + \left(\varepsilon_{1} - \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \right) \left(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) + \varepsilon_{3} \right) \xi^{2} \right] \times (12) \\
\times \left[\left(\varepsilon_{1} + \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \right) \left(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) + \varepsilon_{3} \right) + \left(\varepsilon_{1} - \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \right) \left(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) - \varepsilon_{3} \right) \xi^{2} \right]^{-1} R_{2}^{2}.$$

Потенциал $\Phi_3(r,\theta)$ и напряженность $\mathbf{E}_3(r,\theta)$ поля вблизи слоистого цилиндрического композита с замагниченной оболочкой определяются выражениями

$$\Phi_{3}(r,\theta) = -\mathbf{\ddot{I}} \cdot \mathbf{n}_{0} \mathbf{n}_{\theta} E_{0} r + \mathbf{\ddot{A}}(\omega | \mathbf{B}) \mathbf{E}_{0} \mathbf{n}_{\theta} / r.$$

$$\mathbf{n}_{0} = \mathbf{E}_{0} / |\mathbf{E}_{0}|, \mathbf{n}_{\theta} = \mathbf{r} / |\mathbf{r}|,$$

$$\mathbf{\ddot{I}} = \mathbf{\ddot{I}} \cdot \mathbf{\ddot{I}} = \mathbf{\ddot{I}} = \mathbf{\ddot{I}} \cdot \mathbf{\ddot{I}} = \mathbf{\ddot{I}} = \mathbf{\ddot{I}} \cdot \mathbf{\ddot{I}} = \mathbf{\ddot{I$$

$$\mathbf{E}_{3}(r,\theta) = \mathbf{E}_{0} - \vec{\nabla} \ddot{\mathbf{A}}(\varepsilon_{1}, \vec{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{3}) \mathbf{E}_{0} \mathbf{r} / r^{2}.$$
(14)

Картина распределения напряженности поля ${\bf E}_3(r,\theta)$ для этого случая представлена на рис. 2 для двух различных частот ω и постоянном магнитном поле индукции ${\bf B}{=}10~{\rm Tr}$.

При выключении магнитного поля все тензорные величины редуцируются к своим скалярным прототипам и (10)-(12) трансформируются к выражениям для поляризуемостей изотропного слоистого композита [4]. Тогда скалярный фактор Лоренца $B(\omega)$ усиления поля в корде принимает вид

$$B(\omega) = \frac{\varepsilon_{3} + \varepsilon_{2}(\omega)}{\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2}(\omega)} + \frac{\varepsilon_{3} - \varepsilon_{2}(\omega) \left[\left(\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2}(\omega) \right) \left(\varepsilon_{2}(\omega) - \varepsilon_{3} \right) + \left(\varepsilon_{1} - \varepsilon_{2}(\omega) \right) \left(\varepsilon_{2}(\omega) + \varepsilon_{3} \right) \xi^{2} \right]}{\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2}(\omega) \left[\left(\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2}(\omega) \right) \left(\varepsilon_{2}(\omega) + \varepsilon_{3} \right) + \left(\varepsilon_{1} - \varepsilon_{2}(\omega) \right) \left(\varepsilon_{2}(\omega) - \varepsilon_{3} \right) \xi^{2} \right]}.$$

$$(15)$$

Если $\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = 1$ (проводящая цилиндрическая оболочка в вакууме) из (15) получаем

$$B(\omega) = \frac{4\varepsilon_2(\omega)}{\left[\varepsilon_2(\omega) + 1\right]^2 - \left[\varepsilon_2(\omega) - 1\right]^2 \xi^2},$$
(16)

как и в задаче 3 главы 1 известного курса теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица [5].

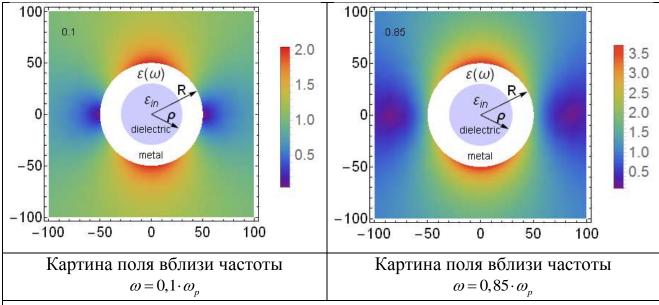


Рис. 2. Структура ближнего поля вне двуслойной нанопроволоки из металлической оболочки и диэлектрического корда, находящейся во внешнем монохроматическом поле $\mathbf{E}_0(\omega)$ частоты ω и постоянном магнитном поле индукции $\mathbf{B}=10$ Тл для двух различных частот ω падающей волны. Замагниченная электронная плазма проводящей оболочки. Вектор индукции магнитного поля \mathbf{B} || оси OZ, а \mathbf{E}_0 || оси OY. $\mathbf{R}_2=50$ нм, $\mathbf{R}_1=30$ нм, $\gamma=10^{12}\,\mathrm{c}^{-1}$, $\varepsilon_1=1$, $\varepsilon_3=1,2$; $\omega_p=1,38\cdot10^{16}\,\mathrm{c}^{-1}$. Резонансные частоты $\omega_{res1}=5,94\cdot10^{15}\,\mathrm{c}^{-1}$ и $\omega_{res2}=1,22\cdot10^{16}\,\mathrm{c}^{-1}$.

Поглощение света молекулой вблизи поверхности слоистого наноцилиндра

Поглощение света молекулой в ближнем поле нанокомпозита, помещенного в однородное монохроматическое поле $\mathbf{E}_0 \exp(-i\omega t)$ будет определяться, в том числе, и той составляющей общего поля, которая

формируется в результате поляризации цилиндрического нанокомпозита. Как и в предыдущем разделе выделим три характерные пространственные области

1:
$$0 < r < R_1$$
, $\varepsilon_1(\omega)$, \mathbf{E}_1

2:
$$R_1 < r < R_2$$
, ε_2 , $\mathbf{E}_2(r,\theta)$
3: $R_2 < r$, ε_3 , $\mathbf{E}_3(r,\theta)$

3:
$$R_2 < r$$
 , ε_3 , $\mathbf{E}_3(r,\theta)$

в каждой из которых, диэлектрические проницаемости $\varepsilon_1(\omega), \varepsilon_2, \varepsilon_3$ не зависят от координат, а в материалах, заполняющих области 2 и 3, к тому же, отсутствует частотная дисперсия. Поле в центральной жиле композита однородно \mathbf{E}_1 =const, тогда как поля в оболочке и вне композита зависят от полярных координат (r,θ) точек областей 2 и 3.

Если молекула находится вблизи поверхности нанокомпозита (в его ближнем поле), а ее электронный дипольный момент перехода $\mathbf{p}_{if} = \langle i \, | \, \hat{\mathbf{p}} \, | \, f \, \rangle$ между основным i и возбужденным f состояниями известен, скорость $w(\omega | r, \theta)$ поглощения фотонов молекулярной системой будет определяться выражением [6]

$$w(\omega \mid r, \theta) = \frac{2\gamma}{\hbar^2} \frac{\left| \mathbf{p}_{if} \mathbf{E}_3(r, \theta) \right|^2}{\left[(\omega - \omega_{if})^2 + \gamma^2 \right]},$$
(17)

где $\mathbf{E}_{3}(r,\theta)$ – напряженность результирующего (локального) поля в точке расположения молекулы вне цилиндра с оболочкой ($R_2 < r$), определенная формулой, эквивалентной (14)

$$\mathbf{E}_{3}(r,\theta) = \mathbf{E}_{0} + \ddot{\mathbf{G}}_{2}(r,\theta)\ddot{\mathbf{A}}(\varepsilon_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3})\mathbf{E}_{0}, \tag{18}$$

где $\ddot{\mathbf{G}}_2(r,\theta) = r^{-2}[2\mathbf{n}\otimes\mathbf{n} - \ddot{\mathbf{I}}]$ – двумерный тензор Грина квазистатического поля поляризованного цилиндра; $\omega_{_{\!\mathit{if}}}$ – резонансная частота внутримолекулярного радиационного перехода $i \to f$; $\gamma-$ ширина Лоренцева контура полосы поглощения молекулы. Другие максимумы в спектре поглощения (16) будут обусловлены плазмонными резонансами тензора $\ddot{\mathbf{A}}(\omega|\varepsilon_1(\omega|\mathbf{B}),\varepsilon_2,\varepsilon_3)$ удельной поляризуемости композитного цилиндра. Второе слагаемое в правой части (18) определяет вклад поля двумерного диполя в напряженность суммарного поля вне цилиндра. Подчеркнем, что скорость поглощения фотонов (17), вслед за локальным полем (18), является магнитозависимой величиной. В отсутствие магнитного поля дипольная поляризуемость единицы длины слоистого композитного цилиндра с осевой проводящей жилой из металла со скалярной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_1(\omega)$ может быть записана в виде:

$$\alpha\left(\varepsilon_{1}(\omega), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}\right) = \frac{\left[\left(\varepsilon_{1}(\omega) + \varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2} - \varepsilon_{3}) + \left(\varepsilon_{1}(\omega) - \varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2} + \varepsilon_{3})\xi^{2}\right]}{\left[\left(\varepsilon_{1}(\omega) + \varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2} + \varepsilon_{3}) + \left(\varepsilon_{1}(\omega) - \varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2} - \varepsilon_{3})\xi^{2}\right]}R_{2}^{2}.$$
 (19)

Даже в простейшем случае бездисперсионной диэлектрической оболочки ее наличие в композите приводит к смещению частоты плазмонного резонанса для поляризуемости (19), что дает возможность плавной настройки поглощения энергии электромагнитного поля молекулой, размещенной на внешней поверхности слоистой наноструктуры.

Поглощение света молекулой, внедренной в оболочку композитного наноцилиндра. Трансформационные тензоры слоистого наноцилиндра

Если фотоактивная молекула инкорпорирована в оболочку композита, скорость поглощения ею энергии электромагнитного поля будет определяться не только эффективной поляризуемостью $\ddot{\mathbf{A}}(\omega | \mathcal{E}_1(\omega | \mathbf{B}), \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3)$ системы, а другими, более сложными трансформационными тензорами $\ddot{\mathbf{D}}, \ddot{\mathbf{C}}, \ddot{\mathbf{B}}$, связанными с тензором $\ddot{\mathbf{A}}$.

Тензор **B** уже был определен ранее равенством (11). Тензор **D** находим складывая равенства (8)

$$\ddot{\mathbf{D}} = \left[\ddot{\mathbf{B}} - \ddot{\mathbf{I}} + \ddot{\mathbf{A}} / R_2^2 \right] \left[1 / R_2^2 - 1 / R_1^2 \right]^{-1}.$$
 (20)

Наконец для тензора С получаем

$$\ddot{\mathbf{C}} = \ddot{\mathbf{B}} + \ddot{\mathbf{D}} / R_1^2. \tag{21}$$

Локальное поле $\mathbf{E}_2(r,\theta)$ внутри оболочечного слоя неоднородно и определяется выражением

$$\mathbf{E}_{2}(r,\theta) = \vec{\nabla} \left[\ddot{\mathbf{C}}(\varepsilon_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}) - \ddot{\mathbf{D}}(\varepsilon_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}) / r^{2} \right] \mathbf{E}_{0}\mathbf{r}, \tag{22}$$

где тензоры $\ddot{\mathbf{C}}(\varepsilon_1(\omega|\mathbf{B}), \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ и $\ddot{\mathbf{D}}(\varepsilon_1(\omega|\mathbf{B}), \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ связаны друг с другом соотношением (21), а тензор \mathbf{B} определен равенством (11).

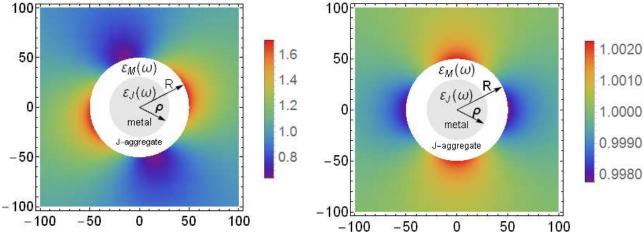
Заметим, что все трансформационные тензоры $\ddot{\mathbf{B}}$, $\ddot{\mathbf{C}}$, $\ddot{\mathbf{D}}$ (как и тензор поляризуемости $\ddot{\mathbf{A}}(\omega|\,\mathcal{E}_1(\omega|\,\mathbf{B}),\mathcal{E}_2,\mathcal{E}_3))$ зависят от индукции внешнего магнитного поля. Скорость $w(\omega|\,R_2>r>R_1,\theta)$ поглощения фотонов молекулами, внедренными в диэлектрическую оболочку цилиндрического нанокомпозита будет по-прежнему определяться выражением (17), однако

вместо поля $\mathbf{E}_3(r,\theta \,|\, \mathbf{B})$ в нем теперь должна фигурировать величина $\mathbf{E}_2(r,\theta \,|\, \mathbf{B})$ — напряженность локального электрического поля в точке расположения молекулы внутри оболочечного слоя $R_2 > r > R_1$.

Поглощение света молекулами и скорость генерация экситонов Френкеля в оболочечном слое молекулярных J – агрегатов композитного наноцилиндра

В случае, когда проводящий наноцилиндр окружен оболочкой из органических молекул (например, цианиновых красителей), сгруппированных в Ј-агрегаты, образуется квазикристаллический слой, представляющий собой однородно поглощающую свет систему, с генерацией в этом слое экситонов Френкеля. В этом случае, скорость $w(\omega | R_1, R_2)$ поглощения фотонов оболочкой цилиндрического нанокомпозита будет определяться интегралом от квадрата напряженности $\mathbf{E}_2(r,\theta)$ локального поля в слое толщиной $\Delta R = R_2 - R_1$ [4]

$$w(\omega \mid R_1, R_2) = \frac{\omega}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \operatorname{Im} \varepsilon_2(\omega) \left| \mathbf{E}_2(r, \theta \mid \omega) \right|^2 \pi d\theta \, r dr \,. \tag{23}$$



Картина поля вблизи резонансной частоты $\omega_{res1} = 0,721 \cdot \omega_p$

Картина поля вблизи резонансной частоты $\omega_{res2} = 0, 6 \cdot \omega_p$

Рис. 3. Картина распределения напряженности ближнего поля вне слоистого поляризован-ного наноцилиндра с оболочкой из молекулярных J-агрегатов и замагниченной электронной плазмой проводящего корда. Индукция магнитного поля B=10 Tл, B || оси OZ, E_0 || оси OY. R_2 =50 нм, R_1 =30 нм, $\gamma = 10^{12}\,\mathrm{c}^{-1}$, $\Omega^2 F = 3 \cdot 10^{15}\,\mathrm{c}^{-1}$, $\omega_{res}(0) = 4,61 \cdot 10^{15}\,\mathrm{c}^{-1}$, $\Gamma = 10^{11}\,\mathrm{c}^{-1}$

Диэлектрическая проницаемость ε_2 покрывающего слоя в этом случае имеет сильную частотную зависимость, обусловленную наличием экситонных мод в кристаллоподобном материале оболочки [7]

$$\varepsilon_2(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\Omega^2 F}{\left[\omega + i\Gamma(\omega)\right]^2 - \omega_{res}^2(0)},$$
(24)

где ε_0 – диэлектрическая проницаемость, обусловленная всеми другими состояниями электронов, кроме экситонных состояний; $\Gamma(\omega)$ – скорость релаксации, обусловленная взаимодействием экситонов с фононами; Ω^2 – квадрат «плазменной частоты» электронов оболочечного слоя; F – сила осциллятора экситонного перехода; $\omega_{res}(0)$ – частота середины экситонной зоны – с нулевым волновым вектором ${\bf k}$. Далее в расчетах использовались значения частотных параметров экситонов, характерные для органических молекулярных кристаллов: $\Omega^2 F = 3 \cdot 10^{15} \,\mathrm{c}^{-1}$, $\Gamma = 10^{11} - 10^{14} \,\mathrm{c}^{-1}$, $\omega_{res}(0) = 10^{15} \,\mathrm{c}^{-1}$ [7]. Заметим, что использование для расчетов скорости поглощения композитом энергии инициирующего поля \mathbf{E}_0 мнимой части удельной поляризуемости $\operatorname{Im} \alpha(\omega | \varepsilon_1(\omega), \varepsilon_2(\omega), \varepsilon_3)$ дает величину *полной* скорости поглощения, с учетом и той части энергии, которая диссипирует в металле композита при затухании его плазмонных мод. С другой стороны, выражение (23) учитывает лишь инициирующего поля оболочкой энергии непосредственно дает скорость генерации экситонов в ней. В качестве примера на рис. 3 представлены карты распределения напряженности ближнего поля вне слоистого поляризованного наноцилиндра с оболочкой из молекулярных Јагрегатов и замагниченной электронной плазмой (В=10 Тл) проводящего корда для двух различных частот ω , близких к резонансным. Высокочастотный резонанс может считаться условно плазмонным, и именно для него влияние магнитного поля является наиболее отчетливо выраженным [8].

В спектре поляризуемости $Im(\alpha)$ проводящего цилиндра с диэлектрической оболочкой, на плазмонной частоте возникает резонанс, обусловленный воздействием электрического поля волны на металлическую сердцевину композита. В том случае, когда металлическая жила покрыта слоем молекулярных Ј-агрегатов, кроме плазмонного пика в диапазоне частот $0.6 \ \ 0.65 \omega_n$, в низкочастотной области спектра возникают два экситонных резонанса [8]. С увеличением радиуса проводящей жилы, плазмонный резонансный пик увеличивается по амплитуде и смещается с высокочастотную область. Кроме того, с увеличением силы осциллятора экситонного перехода спектральная амплитуда удельной поляризуемости композита в области экситонной полосы увеличивается, а в области плазмонной полосы уменьшается, при этом экситонные резонансы расходятся по частоте относительно друг друга с большим размахом, нежели плазмонные [8]. С увеличением частоты перехода, отвечающей центру экситонной зоны, экситонная полоса удельной поляризуемости, в свою очередь, смещается в высокочастотную область, при этом происходит и незначительное смещение максимума плазмонной полосы в том же направлении.

Таким образом, в работе получено точное решение задачи о поглощении энергии электромагнитного поля молекулами и кристаллоподобными молекулярными агрегатами, образующими внешнюю оболочку протяженного проводящего наноцилиндра при наличии внешнего магнитного поля.

Приведены аналитические выражения ДЛЯ дипольной поляризуемости композитного электронной наноцилиндра c замагниченной металлического компонента в прозрачной стеклообразной среде. Учитывалось, что в кристаллоподобных молекулярных оболочках слоистых цилиндров возникают экситоны Френкеля, обусловливающие появление новых резонансов в функции отклика. Дальнейшая безызлучательная трансформация экситонов в аксиально-симметричной системе может быть рассмотрена с помощью методов, изложенных в [9], где проведен анализ релаксации экситонов Ваннье-Мотта в полупроводниковых квантовых нитях.

Авторы благодарны Г.С. Коловертнову за помощь в проведении расчетов полей нанокомпозитов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства Оренбургской области (проект № 16-42-560671), а также Министерства образования и науки РФ (Госзадание № 233).

Список литературы

- 1. Kucherenko, M.G. Dynamics and relaxation of excited molecular states in local field of composited nanoparticles and external magnetic field / M.G. Kucherenko // Russian-Japanese Conference «Chemical Physics of Molecules and Polyfunctional Materials»: Proceedings. OSU. Orenburg. IPK «Universitet». 2014. P.13-15.
- 2. Гинзбург, В.Л. Волны в магнитоактивной плазме / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе // М.: Наука. 1975. -256 с.
- 3. Кучеренко, М.Г. Локализованные плазмоны в замагниченном наноцилиндре и сферическом слоистом композите с анизотропной сердцевиной или оболочкой / М.Г. Кучеренко // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции. Оренбургский гос. ун-т. Электрон. дан. —Оренбург: ОГУ, 2016. С. 1220-1227.
- 4. Кучеренко, М.Г. Трансформация энергии в цилиндрической наноструктуре из металлической жилы и коаксиальной оболочки с молекулами люминофора / М.Г. Кучеренко, Т.М. Чмерева // Журнал приклад. спектр. 2017.
- 5. Ландау, Л. Д. Электродинамика сплошных сред. Теоретическая физика. Т.8. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц // М.: Физматлит. 2010. -656 с.
- 6. Kucherenko, M.G. Absorption and spontaneous emission of light by molecules near metal nanoparticles in external magnetic field / M.G. Kucherenko, V.M. Nalbandyan // Physics Procedia 73 (2015) 136 142. doi: 10.1016/j.phpro.2015.09.134 © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.
- 7. Давыдов, А.С. Теория твердого тела / А.С. Давыдов. // М.: Наука, 1976. –640 с.
- 8. Кучеренко, М.Г. Трансформация спектров удельной поляризуемости слоистых нанопроволок в магнитном поле / М.Г. Кучеренко, В.М. Налбандян // Универ. комплекс как регион. центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 1-3 февр. 2017 г., Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. Электрон. дан. Оренбург , 2017. (Настоящий сборник).

9. Кучеренко, М.Г. Экситон-плазмонное взаимодействие в системе «полупроводниковая квантовая нить - сферическая металлокомпозитная наночастица» / М.Г. Кучеренко, Т.М. Чмерева // В сб.: Универ. комплекс как рег. центр образования, науки и культуры. Матер. Всеросс. научно-метод. конфер. Оренбург. 2015. С. 1097-1106.